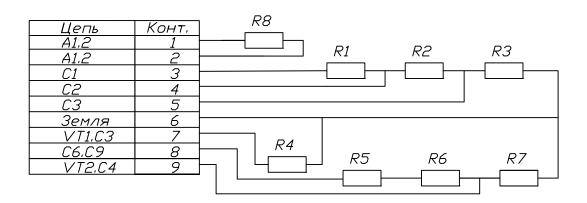
VE XXXXXX 00133



Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
R1	Резистор 0.47 кОм ±20%	1	
R2,R5,R6,R8	Резистор 10 кОм ±20%	4	
R3	Резистор 3.3 кОм ±20%	2	
R4	Резистор 0.27 кОм ±20%	1	
R7	Резистор 6.8 кОм ±20%	1	

Взам. инв.					1		1		
.u gama						<i>АБ.ХХХХХ</i> . (901Э. _{Лит.}	3 Macca	Масштаб
Подп. и	Изм	Лист	докум.	Подп.	Дата			17/4000	Macamao
Ľ	Разр		Жеребин В.Р.	riogri.	7,4,7,16	Резистивная микросборка			1:1
	Про		•						
подл.	Т. к	онтр.					Лист 1	Лис	тов 5
ŭ								ниу м:	au
Инв.	H. *	онтр.						3P-15-	
Z	Утв	3.							

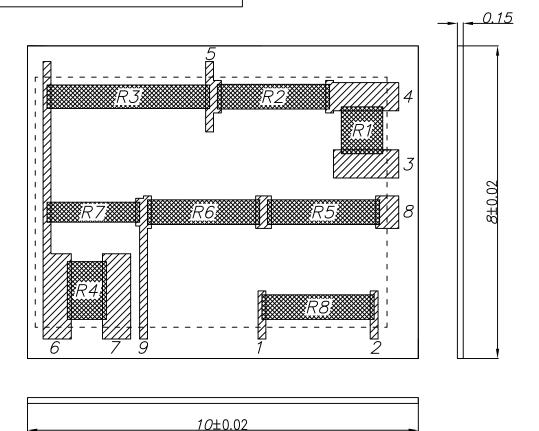


Таблица 1

Условное	Наименование		Материал слоя								
обозначение слоя	слоя	Марка	ГОСТ, ОСТ, ТУ	Электрическая характеристика	Метод нанесения						
	Проводники и контактные	Нихром X20H80	ГОСТ 10994—74	0.04 OM	Фотолитографический						
	площадки	Золото Зл9999	ГОСТ 6835—72	0.04 OM	Фотолитографический						
	Резистивный слой	Сплав PC—3001	ETO.021019 TY	10 кОм	Фотолитографический						
	Защитный слой	Фоторезист негативн. ФН—11	TY-14-631-7B								

1. Размеры для справок (мм).

инв.

- 2. Элементы в слоях выполнять по координатам, приведенным в таблицах на соответствующих листах
- 3. Характеристики отдельных слоев приведены в табл. 1. 4. Номера контактных площадок и обозначение элементов показаны условно и соответствуют схеме электрической принципиальной АБ. XXXXXX 001 ЭЗ.

gama						АБ. ХХХХХХ. С	002	СБ		
n.u							Лит.	М	асса	Масштаб
Подп.	Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Postiomuliuga Mukroofonka				
	Разј	раб.	Жеребин В.Р.			Резистивная микросборка Сборочный чертеж			10:1	
	Про	в.				coope mad ropmon				
подл.	Т. к	онтр.					Лист	2	Лисп	10B 5
ž								_	ниу мэн	1/1
Инв.	H. 1	контр.							1019 MISI P-15-1	
Z	Vm	R						0,	, , ,	J

YE'XXXXXX'002

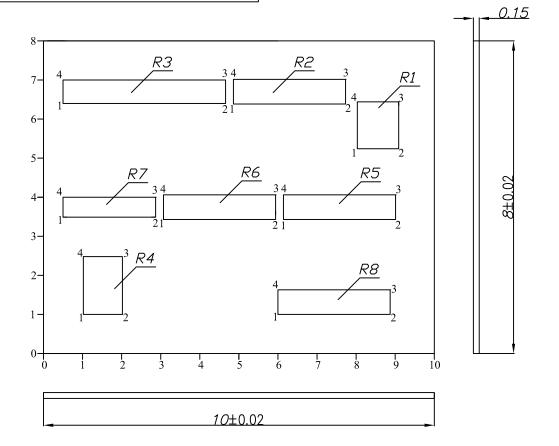


Таблица 2

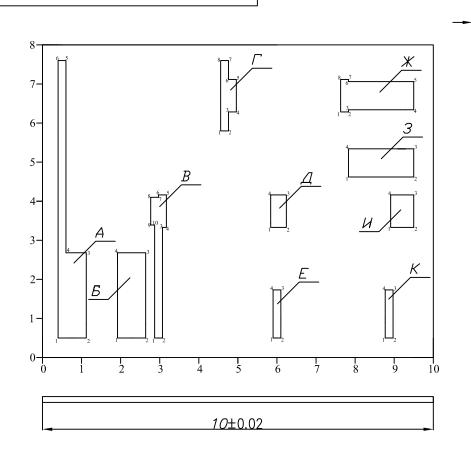
- 1. Размеры для справок (мм). 2. Шаг координатной сетки 1 мм.
- 3. Координаты для нанесения резистивного слоя приведены в табл. 2.

Обоз.	Номер	Координ	ата, мм	Обоз. элем.	Номер	Координ	ата, мм
элем.	вершины	X	У		вершины	X	У
R1	1 2 3 4	8.03 9.09 9.09 8.03	5.24 5.24 6.44 6.44	R5	1 2 3 4	6.14 9.01 9.01 6.14	3.43 3.43 4.06 4.06
R2	1 2 3 4	4.86 7.73 7.73 4.86	6.88 6.88 7.01 7.01	R6	1 2 3 4	3.07 5.94 5.94 3.07	3.43 3.43 4.06 4.06
R3	1 2 3 4	0.50 4.66 4.66 0.50	6.40 6.40 7.00 7.00	R7	1 2 3 4	0.50 2.87 2.87 0.50	3.49 3.49 4.00 4.00
R4	1 2 3 4	1.02 1.00 1.00 1.02	2.02 2.02 2.48 2.48	R8	1 2 3 4	6.00 8.87 8.87 6.00	1.00 1.00 1.63 1.63

Взам.						R4	2 3 4	1.00 1.00 1.02	2.02 2.48 2.48	R8	3 4		8.87 8.87 6.00	1.00 1.63 1.63
gama								АБ.	XXXX	(XX.	.005	3		
n.u						Лит. Масса Маси								
Подп.	Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Pes	вистивная	я микро	сборка					
	Разр	раб.	Жеребин В.Р.			1	Маска для							10:1
	Про	в.					резистив	вного с	:ЛОЯ					
подл.	Т. к	онтр.								Лист З Листов 5		10B 5		
ŭ							Cosce	<i>MIT</i> 7	N 1			,	1141/ 1421	
Инв.	H. 14	онтр.						МЛТ—З1 28.00 Т.					НИУ МЭІ Р—15—1	I
Z	Утв	3.					0,10.02	.0.00 7.	,				, , , , ,	

700 XXXXXX OOT

инв.



1. Размеры для справок (мм).

0.15

- 2. Шаг координатной сетки 1 мм.
- 3. Координаты для нанесения проводников и контактных площадок приведены в табл. 3.

Таблица З

Обоз Номер		Координ	ата, мм		Номер	Координ	ата, мм	Обоз	Номер	Координ	ата, мм
элем.	вершины	x y		элем.	вершины	X	У	элем.	вершины	X	У
	1	0.40	0.50		1	4.56	5.80		4	9.50	6.34
	2	1.12	0.50		2	4.76	5.80		5	9.50	7.06
,	3	1.12	2.68		3	4.76	6.28	Ж	6	7.83	7.06
A	4	0.60	2.68	г	4	4.96	6.28		7	7.83	7.12
	5	0.60	7.60	1	5	4.96	7.12		8	7.63	7.12
	6	0.40	7.60		6	4.76	7.12				
		4.02	0.50		7	4.76	7.60		1	7.83	4.62
	1	1.92	0.50		8	4.56	7.60	3	2	9.50	4.62
Б	2	2.64	0.50		1	5.84	3.33	,	3	9.50	5.34
	3	2.64	2.68		2	6.24	3.33		4	7.83	5.34
	4	1.92	2.68	Д	3	6.24	3.33 4.16				
	1	2.87	0.50	, ,	4	5.84	4.16		1	8.91	3.33
	2	3.07	0.50			3.64	4.10	т.т	2	9.50	3.33
	3	3.07	3.33		1	5.90	0.50	И	3	9.50	4.16
	4	3.17	3.33	г	2	6.10	0.50		4	8.91	4.16
	5	3.17	4.16	Е	3	6.10	1.73				
B	6	2.97	4.16		4	5.90	1.73		1	0 77	0.50
	7	2.97	4.10						1	8.77 8.97	0.50
	8	2.77	4.10		1	7.63	6.28	К	2 3	8.97 8.97	0.50 1.73
	9	2.77	3.39	Ж	2	7.83	6.28		3 4	8.97	1.73
	10	2.87	3.39		3	7.83	6.34		4	0.77	1./3

B3			10	2.	87 3	.39		3	7.83	6.34		4	+	8.77	1./3
gama									АБ.	XXXX	(XX	.00	4		
Подп. и												Лит.	. ^	1acca	Масштаб
110	Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дат	<u>a</u>		вистивная			'				
	Разр	раб.	Жеребин В.	P.				Маска для							10:1
	Про	<i>в</i> .					K	онтактні	ых плои	цадок					
подл.	Т. к	онтр.										Лист	1 4	Лист	moß 5
						4	Meg	дь с пода	слоем в	Ванадия	1		ŀ	чиу мэ.	и
Инв.	H. r	контр.				4		(лух	кеная)					P-15-1	
Z	Ут	3 .													

Форм.	Зона	Поз.	(Эбозн	зчен	ue		Наименова	ние	Кол.	Прим.
								Документа	ция		
Α4			AБ. XXXX	XX.001	93			Схема электри	ческая		
								принципиальна			
A4			AB. XXXX	XX.002	2СБ			Сборочный чер	теж		
								Детали			
								Подложка		1	
								Резисто	ры		
									·		
								$0.47 \text{ kOm} \pm 20$		1	R1
								10 кОм ± 20%		4	R2,R5,R6,R8
								3.3 кОм ± 20%		1	R3
								$0.27 \text{ kOm} \pm 20$		1	R4
								6.8 кОм ± 20%	7 0	1	R7
								<u> </u> АБ. XXXXX	X.005		
Изм.	Лис	cm g	докум.	Подп.	Дата				Лит.	Масса	Масшта
Раз _і Про	в.		еребин В.Р.			ļ F	Резисти	Вная микросборка	Лист 5		cmo8 5
	конт конп в										'ЭИ

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. подл.